

## PN 结 Si 光电池

### 描述

工作在低频区域的 Si 光电池，可接收波长处于峰值波长附近的光信号。

### 应用

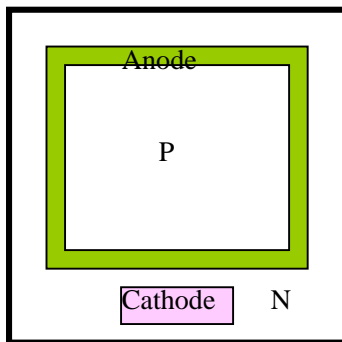
- 遥控电路
- 光纤通信

### 结构

芯片结构：平面 PN 型结构

电极：顶部 AlSi

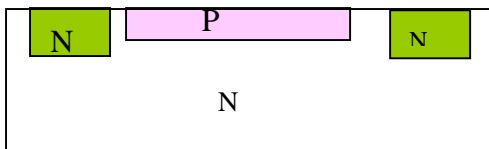
### 外形图和尺寸



芯片尺寸：4.0 mm × 4.0 mm

芯片厚度：300±25μm

### 纵向结构



芯片结构：平面 PN 型结构

电极：AlSi

**光电特性** (Ta=25° )

| 参数                                  | 符号       | 测试条件                          | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------|-----|-----|-----|----|
| 暗电流<br>Reverse dark current         | $I_D$    | $V_R=10V$ $E=0mW/cm^2$        |     |     | 30  | nA |
| 反向击穿电压<br>Reverse breakdown voltage | $V_{BR}$ | $I_R=100\mu A$ , $H=0mV/cm^2$ |     |     | 50  | V  |